

## Intel e Micron per memorie Flash NAND superveloci

- Ultima modifica: Domenica, 03 Febbraio 2008 13:45

Pubblicato: Domenica, 03 Febbraio 2008 11:18

Scritto da Laura Benedetti



Intel e Micron costituiscono la joint-venture IM Flash Technologies (IMFT) allo scopo di cooperare allo sviluppo di una nuova generazione di chip di memoria NAND Flash fino a 5 volte piu' veloci.

La tecnologia **Flash NAND**, sempre più utilizzata in alternativa alle unità di archiviazione a piatti magnetici su dispositivi mobile, raggiunge oggi un significativo traguardo. **Intel**, noto chipmaker americano, e **Micron**, azienda leader nella produzione di memorie DRAM, memorie Flash NAND e sensori CMOS, hanno [annunciato](#) la nascita di un duraturo sodalizio, tramite la **joint-venture IM Flash Technologies (IMFT)**, per la creazione e produzione di **moduli di memoria Flash NAND più veloci**, capaci di raggiungere una velocità 5 volte maggiore rispetto alle memorie NAND attualmente in commercio.

La nuova tecnologia potrà vantare una velocità in lettura di 200 MB/sec, doppia rispetto a quella in scrittura pari a 100 MB/sec, contro 40 MB/sec (lettura) e 20 MB/sec (scrittura) delle memorie Flash SLC (Single Level Cell) attuali. L'incremento delle prestazioni è dovuto probabilmente al nuovo standard ONFI 2.0 che, in accordo con quanto dichiarato da Open NAND Flash Interface Working Group, riduce il tempo di trasferimento dei dati utilizzando segnali Double Data Rate e fonti sincronizzate.

Queste specifiche tecniche, unite ad un'architettura four-plane e a più elevate frequenze, aiuteranno Intel e Micron nella produzione di chip integrati Flash NAND superveloci. Attualmente comunque non sono ancora noti i costi e le date di rilascio della nuova tecnologia né i tempi necessari per poterla utilizzare su dispositivi consumer.